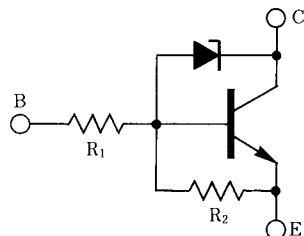


抵抗内蔵NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ

中速度スイッチング用

特 徴

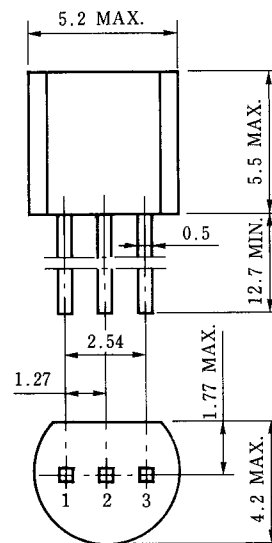
- ICの出力からアクチュエータ等の大電流ドライブが可能です。
- バイアス抵抗を内蔵しています。
- コレクタ・ベース間にツェナーダイオードを内蔵しています。
- ドライブ時の消費電力が小さい。



AD2シリーズ一覧表

品 名	R ₁ (kΩ)	R ₂ (kΩ)
AD2A3M	1.0	1.0
AD2F3P	2.2	10
AD2L3N	4.7	10
AD2A4M	10	10
AD2L2Q	0.47	4.7
AD2F2Q	0.22	2.2
AD2A4A	—	10

外形図 (単位: mm)



電極接続

1. Emitter EIAJ : SC-43B
 2. Collector JEDEC : TO-92
 3. Base IEC : PA33

絶対最大定格 (T_A = 25 °C)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	60±10	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	60±10	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	10	V
コレクタ電流 (直 流)	I _{C(DC)}	1.0	A
コレクタ電流 (パルス)	I _{C(pulse)} *	2.0	A
ベース電流 (直 流)	I _{B(DC)}	0.02	A
全 損 失	P _T	750	mW
ジャンクション温度	T _J	150	°C
保 存 温 度	T _{stg}	-55~+150	°C

*PW≤10 ms, Duty Cycle≤50 %

AD2A3M

電気的特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=40\text{ V}, I_E=0$			100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$	80			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$	200			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE3} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=1.0\text{ A}$	200			—
ロウレベル出力電圧	V_{OL} **	$V_{IN}=5.0\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$			0.35	V
ロウレベル入力電圧	V_{IL} **	$V_{CE}=5.0\text{ V}, I_C=100\text{ }\mu\text{A}$			0.3	V
入 力 抵 抗	R_1		0.7	1.0	1.3	k Ω
E-B 間 抵 抗	R_2		0.7	1.0	1.3	k Ω

**PW $\leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

AD2F3P

電気的特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=40\text{ V}, I_E=0$			100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$	200			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$	300			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE3} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=1.0\text{ A}$	200			—
ロウレベル出力電圧	V_{OL} **	$V_{IN}=5.0\text{ V}, I_C=0.3\text{ A}$			0.3	V
ロウレベル入力電圧	V_{IL} **	$V_{CE}=5.0\text{ V}, I_C=100\text{ }\mu\text{A}$			0.3	V
入 力 抵 抗	R_1		1.54	2.2	2.86	k Ω
E-B 間 抵 抗	R_2		7	10	13	k Ω

**PW $\leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

AD2L3N

電気的特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=40\text{ V}, I_E=0$			100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$	200			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$	300			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE3} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=1.0\text{ A}$	200			—
ロウレベル出力電圧	V_{OL} **	$V_{IN}=5.0\text{ V}, I_C=0.2\text{ A}$			0.2	V
ロウレベル入力電圧	V_{IL} **	$V_{CE}=5.0\text{ V}, I_C=100\text{ }\mu\text{A}$			0.3	V
入 力 抵 抗	R_1		3.29	4.7	6.11	k Ω
E-B 間 抵 抗	R_2		7	10	13	k Ω

**PW $\leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

AD2A4M

電気的特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=40\text{ V}, I_E=0$			100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$	200			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$	300			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE3} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=1.0\text{ A}$	200			—
ロウレベル出力電圧	V_{OL} **	$V_{IN}=5.0\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$			0.2	V
ロウレベル入力電圧	V_{IL} **	$V_{CE}=5.0\text{ V}, I_C=100\text{ }\mu\text{A}$			0.3	V
入 力 抵 抗	R_1		7	10	13	k Ω
E-B 間 抵 抗	R_2		7	10	13	k Ω

**PW $\leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

AD2L2Q

電気的特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=40\text{ V}, I_E=0$			100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$	200			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$	300			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE3} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=1.0\text{ A}$	200			—
ロウレベル出力電圧	V_{OL} **	$V_{IN}=5.0\text{ V}, I_C=1.0\text{ A}$			0.5	V
ロウレベル入力電圧	V_{IL} **	$V_{CE}=5.0\text{ V}, I_C=100\text{ }\mu\text{A}$			0.3	V
入 力 抵 抗	R_1		329	470	611	Ω
E-B 間 抵 抗	R_2		3.29	4.7	6.11	k Ω

**PW $\leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

AD2F2Q

電気的特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=40\text{ V}, I_E=0$			100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$	100			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$	300			—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE3} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=1.0\text{ A}$	200			—
ロウレベル出力電圧	V_{OL} **	$V_{IN}=5.0\text{ V}, I_C=1.0\text{ A}$			0.5	V
ロウレベル入力電圧	V_{IL} **	$V_{CE}=5.0\text{ V}, I_C=100\text{ }\mu\text{A}$			0.3	V
入 力 抵 抗	R_1		154	220	286	Ω
E-B 間 抵 抗	R_2		1.54	2.2	2.86	k Ω

**PW $\leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

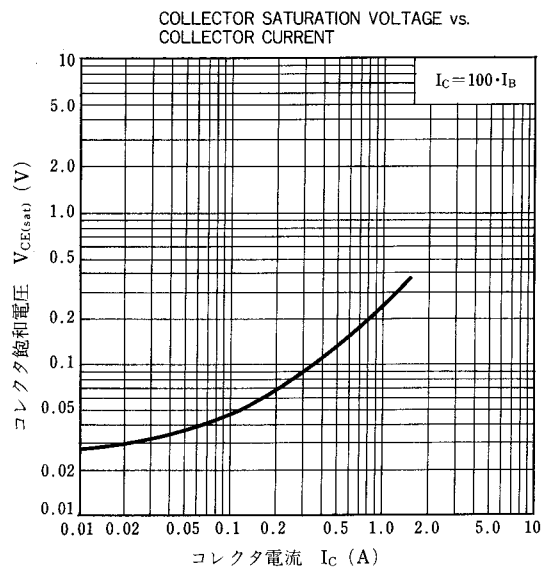
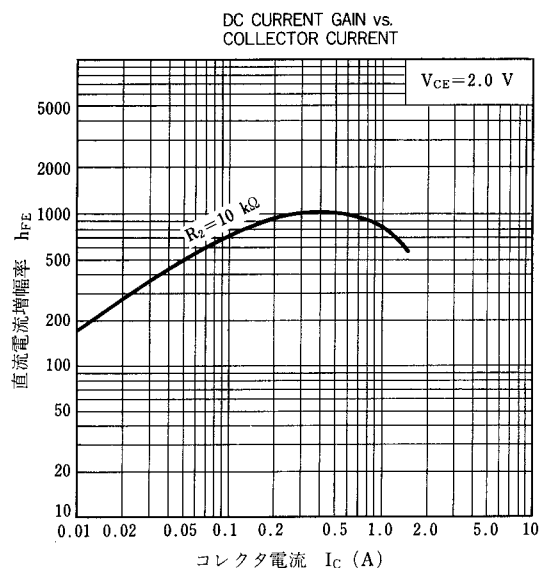
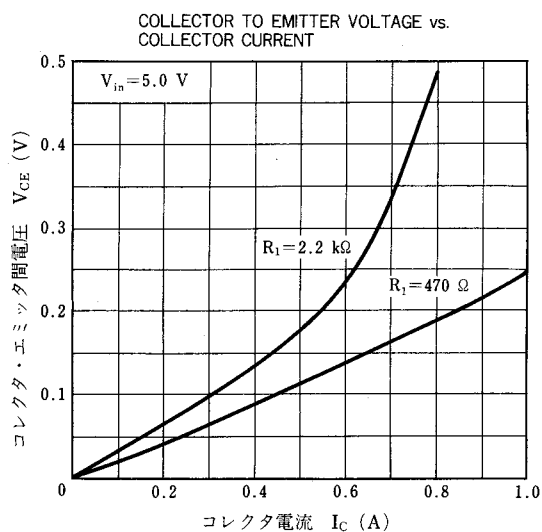
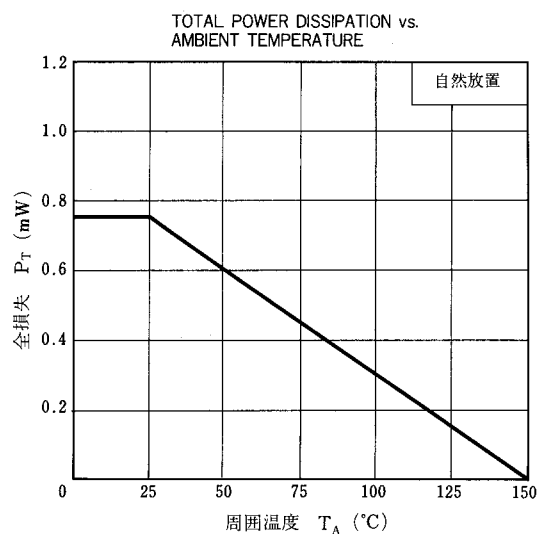
AD2A4A

電氣的特性 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=40\text{ V}, I_E=0$			100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$	200	760		—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$	300	1010		—
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE3} **	$V_{CE}=2.0\text{ V}, I_C=1.0\text{ A}$	200	830		—
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ **	$I_C=1.0\text{ A}, I_B=10\text{ mA}$		0.25	0.4	V
ロウレベル入力電圧	V_{IL} **	$V_{CE}=5.0\text{ V}, I_C=100\text{ }\mu\text{A}$			0.3	V
入 力 抵 抗	R_1		—	—	—	Ω
E-B 間 抵 抗	R_2		7	10	13	k Ω

** $PW \leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

特性曲線 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)



参考資料

資 料 名	資料番号
NEC 半導体デバイスの信頼性品質管理	TEM-521
NEC 半導体デバイスの品質水準	IEI-620
半導体デバイス実装マニュアル	IEI-616
半導体デバイスパッケージ・マニュアル	IEI-635
半導体総合セクションガイド	MF-212
半導体デバイスの品質保証ガイド	MEI-603
縦形部品のテーピング仕様	MEM-507

〔メモ〕

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
- 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
- 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
- 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
- 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

— お問い合わせは、最寄りのNECへ —

【営業関係お問い合わせ先】

半導体第一販売事業部		〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号（NEC本社ビル）	東京	(03)3454-1111	(大代表)									
半導体第二販売事業部														
半導体第三販売事業部														
中部支社 半導体販売部		〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号（NEC中部ビル）	名古屋	(052)222-2170										
関西支社	半導体第一販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号（NEC関西ビル）	大阪	(06) 945-3178	(06) 945-3200									
	半導体第二販売部													
	半導体第三販売部													
北海道支社	札幌	(011)231-0161	小長	山	支	店	(0285)24-5011	三	重	支	店	津	(0592)25-7341	
東北支社	仙台	(022)261-5511	小長	山	支	店	(0262)35-1444	京	都	支	社	都	(075)344-7824	
岩手支店	盛岡	(0196)51-4344	松	野	支	店	(0263)35-1666	神	戸	支	社	神	(078)333-3854	
山形支店	山形	(0236)23-5511	上	諏	訪	支	(0266)53-5350	中	国	取	支	店	島	(082)242-5504
郡山支店	郡山	(0249)23-5511	甲	府	支	店	(0552)24-4141	鳥	取	支	店	鳥	(0857)27-5311	
いわき支店	いわき	(0246)21-5511	埼	玉	支	社	(048)641-1411	岡	山	支	店	岡	(086)225-4455	
長岡支店	長岡	(0258)36-2155	立	川	支	社	(0425)26-5981	四	国	支	店	松	(0878)36-1200	
土浦支店	土浦	(0298)23-6161	千	葉	支	社	(043)238-8116	新	居	浜	支	店	高	(0897)32-5001
水戸支店	水戸	(0292)26-1717	静	岡	支	社	(054)255-2211	松	山	支	店	松	(0899)45-4111	
神奈川支社	横浜	(045)324-5511	浜	松	支	店	(053)452-2711	九	州	支	店	福	(092)271-7700	
群馬支店	高崎	(0273)26-1255	北	陸	支	店	(0762)23-1621	北	九	州	支	店	北九州	(093)541-2887
太田支店	太田	(0276)46-4011	福	井	支	店	(0776)22-1866							
宇都宮支店	宇都宮	(0286)21-2281	富	山	支	店	(0764)31-8461							

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部	〒210	川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎 (044)548-7914	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
汎用デバイス技術部				
半導体販売技術本部	〒108-01	東京都港区芝五丁目7番1号（NEC本社ビル）	東京 (03)3798-9619	
東日本販売技術部				
半導体販売技術本部	〒460	名古屋市中区錦一丁目17番1号（NEC中部ビル）	名古屋 (052)222-2125	
中部販売技術部				
半導体販売技術本部	〒540	大阪市中央区城見一丁目4番24号（NEC関西ビル）	大阪 (06) 945-3383	
西日本販売技術部				

C95.9